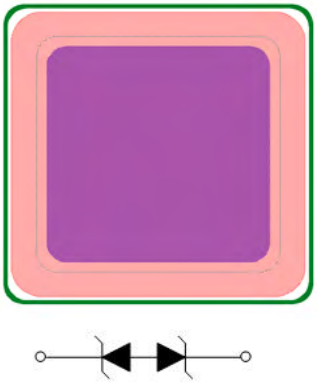
概述

- LM603ESDCP8-0.22 是利用先进的硅电路工艺生产的双向低电容静电放电保护器件；
- 低钳位电压；
- 快速的响应速度；
- 低漏电电流（<500nA）；

  适合于高速数据传输线的ESD保护；

  IEC6100-4-2(ESD)；+/-30KV(空气放电)；+/-30KV(接触放电)



芯片信息

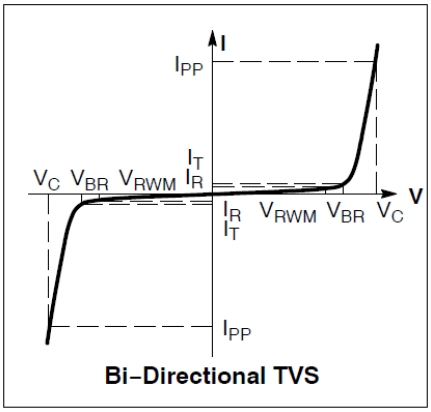
项目	描述
流片代码	KID030
圆片尺寸	6Inch
有效管芯数	320000dies
芯片尺寸	220μm×220μm
压点尺寸	145μm×145μm
芯片厚度	150±10μm/110±10μm/厚片
正面金属	Al:3μm
背面金属	Ti/Ni/Ag 或 Ti/Ni/Sn/Ag
划片道宽度	50μm

极限参数（Tamp=25℃）

参　　数	符 号	额定值	单 位
芯片最高工作温度范围	Topr	-55 ~ +125	℃
芯片最高存储温度范围	Tstg	-55 ~ +150	℃

电性参数（Tamp=25℃）

Symbol	Parameter
I_{PP}	Maximum Reverse Peak Pulse Current
V_C	Clamping Voltage @ I_{PP}
V_{RWM}	Working Peak Reverse Voltage
I_R	Maximum Reverse Leakage Current @ V_{RWM}
V_{BR}	Breakdown Voltage @ I_T
I_T	Test Current
P_{pk}	Peak Power Dissipation
C	Capacitance @ V_R = 0 and f = 1.0 MHz



Bi-Directional TVS

Item	Symbol	Test Conditions	Criterion			Unit
			Min	Typ	Max	
最大峰值功率	P_{PK}	I_{PP}=8A,t_p=8/20μs			100	W
维持电压	V_{RWM}				3.3	V
击穿电压	V_{BR}	I_T=1mA	3.5	4.1	5	V
漏电流	I_R	V_{RWM}=±3.3V			0.5	μA
钳位电压	V_C	I_{PP} =1A,t_p=8/20μs			6.5	V
钳位电压	V_C	I_{PP} =8A,t_p=8/20μs			10	V
电容	C_j	V_R=0V,f=1MHz		15	20	pF

注意事项：

- 芯片存储条件（推荐）：氮气保护，温度 25±5℃，湿度≤45%；
- 封装时，请将距离圆片边沿 3㎜ 及以内位置的管芯剔除；

NOTICE

Leiditech reserves the right to make modifications,enhancements,improvements,corrections or other changes without further notice to any product herein. Leiditech does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein.

Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd.
Email: sale1@leiditech.com
Tel : +86- 021 50828806
Fax : +86- 021 50477059